




Diese Unterlage ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar, verpflichtet zu Schadensersatz und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, BGBl. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung (§ 7 Abs. 1 P.G.) oder der GM-Eintragung (§ 5 Abs. 4 GMG) vorbehalten.

1	2	3	4	5
Lfd. Nr.	Stckz	Benennung	Sach - Nr.	Bemerkungen
D1/0...9	10	Germaniumdiode	L 8011 WN 5457	05201
T1...17	17	Schalttransistor	A 30 WN 5444 od.	A30 WN 5420
T18/0..9	10	"	A 30 WN 5444 "	" WN 5420
R1	1	Schichtwiderstand	20k/2/2 WN 5121	05260
R2	1	"	4k/2/2 WN 5121	05260
R3	1	"	2k/2/2 WN 5121	1722
R4	1	"	2k/2/2 WN 5121	1722
R5	1	"	4k/2/2 WN 5121	05260
R6/0...9	10	"	10k/2/2 WN 5121	05260
R7	1	"	20k/2/2 WN 5121	05260
	10	& 4/8 - 2	2350 - 319 - 1	
	10	F 5b	2350 - 308 - 1	

73 - 543

IF Form 20/0 01-77

Freimaßtoleranzen		Maßstab		OS = 00 Operationspeicher	
Gez.				3E61 - 544 - 1	
Ausg.		Tag		Mittteilung	
Bearbeiter		Geprüft		Normg. Ges.	
c-b 1.5.69 AIF 296-4 <i>Zim</i> b 9.11.60 AIF 296-3 <i>Zim</i> a 5.5.59 AIF 296-2 <i>Zim</i>		 <b>STANDARD ELEKTRIK</b>		Ersatz f. 3961-544-1 Ausg. a.	
				Blatt .2	